

(1) 構造 NPN シリコン エピタキシャル プレーナ形 トランジスタ

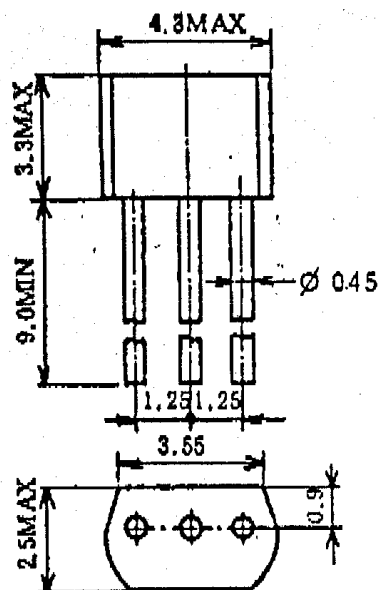
(2) 用途 低周波増幅, 高周波増幅, 発振, スイッチング, 低雑音増幅

(3) 絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

	2SC633SP	2SC634SP
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO} 2.6 V	5.2 V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO} 2.6 V	5.2 V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO} 6 V	
コレクタ電流	I_C 200 mA	
ベース電流	I_B 50 mA	
コレクタ損失	P_O 300 mW	
ジャンクション温度	T_j $+125^\circ\text{C}$	
保存温度	T_{stg} $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$	
熱抵抗	θ_{j-c} 300 $^\circ\text{C}/\text{W}$	

(4) 外形

Dimension in mm



Terminal Connection

- ① : Emmitter
- ② : Collector
- ③ : Base

(7) 電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	検査条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	I _C = 2 mA	2SC633SP	2.6		V
			2SC634SP	5.2		
コレクタ遮断電流	I _{CBO}	V _{CB} = 25 V, I _E = 0			0.15	μA
エミッタ遮断電流	I _{EBO}	V _{EB} = 6 V, I _C = 0			0.8	μA
直流電流増巾率	h _{FE1}	V _{CE} = 3 V, I _C = 1 mA	2SC633SP	21.6	660	
			2SC634SP	8.7	660	
"	h _{FE2}	V _{CE} = 1 V, I _C = 200 mA	4.5			
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(SAT)}	I _C = 50 mA, I _B = 10 mA			0.2	V
エミッタ・ベース間飽和電圧	V _{BE(SAT)}	I _C = 50 mA, I _E = 10 mA			1.2	V
トランジション周波数	f _T	V _{CE} = 6 V, I _E = -2 mA	11.2			MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} = 6 V, I _E = 0, f = 1 MHz			7.0	pF
C _{c, rbb}	C _{crbb}	V _{CE} = 6 V, I _E = -2 mA, f = 31.8 MHz			600	pS

規格細分 (Ta = 25°C)

ランク	h _{FE1} (I _C = 1 mA, V _{CE} = 3 V)	
	最小値	最大値
5	8.7	16.7
6	13.7	26.4
7	21.6	42.2
8	34.6	66.0

マーク標示

